

Транзистор кремниевый  
эпитаксиально-планарный структуры  
n-p-n переключаемый.  
Предназначен для применения в  
переключающих устройствах,  
источниках вторичного  
электропитания. Корпус  
металлический со стеклянными  
изоляторами и жесткими выводами.  
Масса транзистора не более 20 г.

**Электрические параметры**

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ:

при  $U_{кэ} = 5 В, I_k = 20 А$ :

$T = +25^{\circ}C$ .....	12...30*...100*
$T = +125^{\circ}C$ .....	6...50*...150*
$T = -60^{\circ}C$ .....	6...20*...100*

при  $U_{кэ} = 5 В, I_k = 25 А, T = 25^{\circ}C$  .....

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ

при  $U_{кэ} = 10 В, I_k = 0,5 А$ ,  
типовое значение .....

Граничное напряжение при  $I_k = 0,2 А$ ,  
 $L = 25 мГн$ , не менее .....

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер:

$I_k = 20 А, I_о = 4 А$ , не более .....	1,2 В
$I_k = 25 А, I_о = 5 А$ .....	0,5*...1*...1,5* В

Напряжение насыщения база-эмиттер:

$I_k = 20 А, I_о = 3 А$ , не более .....	1,5 В
$I_k = 25 А, I_о = 5 А$ .....	1,2*...1,5*...1,8* В

Время включения при  $U_k = 100 В$ ,  
 $I_k = 25 А, I_о = 5 А$ , не более .....

Время рассасывания при  $U_k = 100 В$ ,  
 $I_k = 25 А, I_о = 5 А$ , не более .....

Время спада при  $U_k = 100 В$ ,  
 $I_k = 25 А, I_о = 5 А$ , не более .....

Обратный ток коллектора при  $U_{кб} = 250 В$ :

$T = +25^{\circ}C$ .....	0,05*...0,5*...3 мА
$T = +125^{\circ}C$ .....	0,1*...1*...6 мА
$T = -60^{\circ}C$ .....	0,05*...0,2*...6 мА

Обратный ток эмиттера при  $U_{кэ} = 7 В$  .....

Емкость коллекторного перехода при  
 $U_{кб} = 10 В$ , не более .....

Емкость эмиттерного перехода при  
 $U_{оэ} = 2 В$ , не более .....

**Предельные эксплуатационные данные**

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при  
 $U_{оэ} = 1,5 В$  или  $R_{оэ} < 10 Ом$  .....

Импульсное напряжение коллектор-эмиттер при  
 $U_{оэ} = 1,5 В$  или  $R_{оэ} < 10 Ом, t_n < 20 мкс, Q > 10$ :

$t_{ф} > 1 мкс$ .....	300 В
$t_{ф} < 1 мкс$ .....	200 В

Постоянное напряжение база-эмиттер .....

Постоянный ток коллектора .....

Импульсный ток коллектора при  $t_n < 20 мкс, Q > 10$  .....

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора<sup>1</sup> при  
 $T_k = +25^{\circ}C$  .....

Температура p-n перехода .....

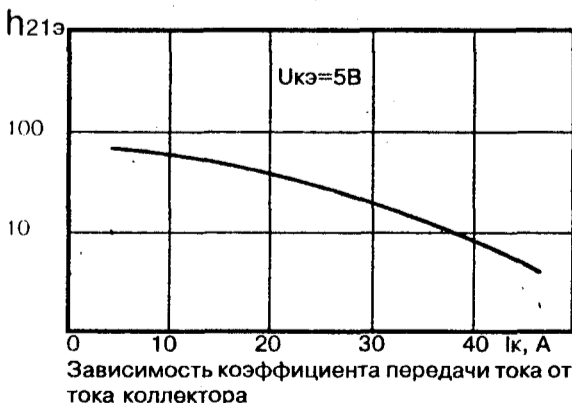
Температура окружающей среды .....

<sup>1</sup>При  $T_k = +25...+125^{\circ}C$   $P_{к, макс}$  рассчитывается по формуле

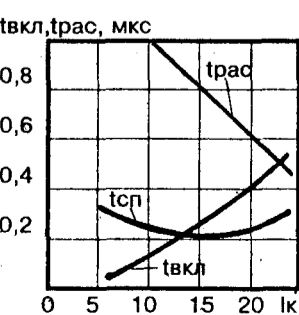
$$P_{к, макс} = (175 - T_k) / 1,5, Вт$$

Допустимое значение статического потенциала 2 кВ.

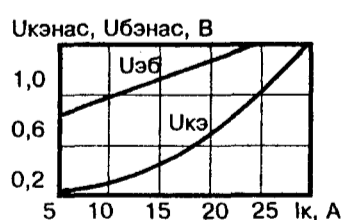
Пайка и лужение выводов рекомендуются не ближе 5 мм от корпуса транзистора с температурой припоя не более +260°C в течение не более 8 с. Минимально допустимое расстояние от корпуса до места пайки 2 мм при температуре пайки не более +150°C.



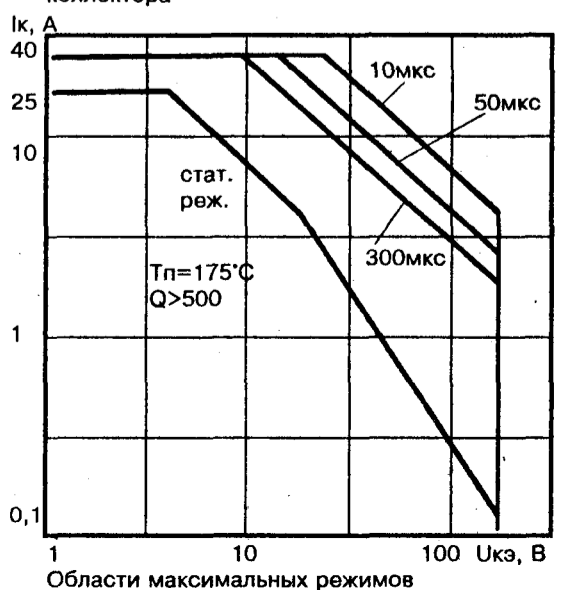
Зависимость коэффициента передачи тока от тока коллектора



Зависимость времени включения, рассасывания и спада от тока коллектора



Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер и база-эмиттер от тока коллектора



Области максимальных режимов